

室蘭工業大学大学院工学研究科
博士後期課程
学生募集要項

中国政府
「国家建設高水平大学公派研究生項目」による
奨学金のための推薦候補者入試
(CSC-MuroranIT 奨学金入試)
2021 年度 10 月入学



Office of Admissions Strategic and Action Plan,
Muroran Institute of Technology
27-1 Mizumoto-cho, Muroran, Hokkaido, JAPAN 050-8585
E-mail nyushi@mmm.muroran-it.ac.jp
<https://www.muroran-it.ac.jp/>

〈 志 願 者 へ 〉

◎あらかじめ指導を希望する教員と十分な連絡をとってから出願してください。
指導教員については以下のURLを参照してください。

<https://www.muroran-it.ac.jp/nyushi/admission/youkou/supervisor2021mc.pdf>

◎室蘭工業大学では、「外国為替及び外国貿易法」に基づき、「国立大学法人室蘭工業大学安全保障輸出管理規則」を定め、外国人留学生の受け入れに際して厳格な審査を実施しています。規制事項に該当する場合は、希望する教育が受けられない場合や研究ができない場合がありますので、注意してください。

◎この要項に記載されている日時はすべて日本標準時です。

個人情報の取扱いについて

本学では、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」等の法令を遵守するとともに、「国立大学法人室蘭工業大学保有個人情報等管理規程」に基づき保有する個人情報の保護に努めます。

出願書類等により得られた個人情報は、本学の入学者選抜業務及び入学者選抜方法検討のための資料として使用します。また、入学者にあつては、教務関係(学籍, 修学指導等)の業務, 学生支援関係(授業料免除, 奨学金等)の業務に使用します。

室蘭工業大学大学院工学研究科博士後期課程の入学受入方針 (アドミッション・ポリシー)

<求める学生像>

1. 幅広い教養と国際的視野を有する人
2. 高い倫理観を有する人
3. 科学技術に関する実践的な研究能力と応用力を有する人

<入学選抜の基本方針>

1. 多様で個性豊かな学生を求めるために、様々な入試選抜方法を実施する
2. 専門分野の高度な知識とその運用能力を身につけていることを重視する
3. 英語を使って情報収集，発信できる能力を身につけていることを重視する

指導教員一覧は以下をご覧ください。【PDFデータ】

(<https://www.muroran-it.ac.jp/nyushi/admission/youkou/supervisor2021dc.pdf>)

授業内容については、本学公式ウェブサイトのシラバスに掲載しています。

(<https://www.muroran-it.ac.jp/kyomu/syllabustop2020/0-r2top-page.htm>)

**中国政府「国家建設高水平大学公派研究生項目」
による奨学金のための推薦候補者入試
(CSC-Muroran-IT 奨学金入試)**

この選抜は、本学と中国政府の中国国家留学基金管理委員会（CSC）との間に締結した協定書に基づき、入学後に「国家建設高水平大学公派研究生項目」による奨学金を受給する学生について、本学からCSCに推薦するにあたり、その候補となりうる者を募集します。

この選抜の合格者は、合格決定後に本学の選考を経てCSCに候補者として推薦されます。

1 募集人員

専攻名	コース名	募集人員	
		2021年10月入学	
		国外出願	国内出願
工学専攻	先端環境創生工学コース	若干名	
	先端生産システム工学コース	若干名	
	先端情報電子工学コース	若干名	

2 入学時期

入学時期は「2021年10月」です。

3 出願資格

中国国籍を有する者のうち、次のいずれかに該当するものとします。

- (1) 中国における211工程（Project 211）に指定された大学において修士の学位を授与された者及び2021年9月30日までに授与される見込みの者
- (2) 中国以外の国の大学において修士の学位を授与された者及び2021年9月30日までに授与される見込みの者

4 研究分野

本選抜に出願する者は、以下の研究分野を入学後の研究テーマとすること。

応用化学、化学生物工学、建築工学、土木工学、機械工学、ロボティクス、材料工学、応用物理学、情報システム学、知能情報学、電気通信システム、電子デバイス計測

5 障害等のある者の事前相談

障害（学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度）等のある者で受験上及び修学上、配慮を希望する場合は、その内容によっては、本学が対応を決定するまでに時間を要することがありますので、できるだけ早い時期に入試戦略課入学試験係へ申し出てください。また、日常生活において使用している補聴器、車椅子等を使用している場合も、同様に申し出てください。

なお、受験上及び修学上の相談については、通年受け付けています。

6 出願手続

(1) 出願期間

2021年1月4日(月)～2021年1月8日(金)

(2) 出願書類等

出 願 書 類 等	摘 要
ア 入学志願票	記入項目欄全てに記入してください。
イ 写真	出願書類受付日前3か月以内に撮影した、上半身脱帽正面向きの写真(縦4cm×横3cm)を志願票の所定欄に貼ってください。
ウ 修了(見込)証明書 (原本又は原本証明)	<p>新型コロナウイルスの影響により、出身大学が封鎖となっているため、大学発行の証明書が入手できない状況が発生しています。</p> <p>そのため、今年度の大学院博士後期課程 CSC-MURORANIT 奨学金入試の募集要項にある出願書類のうち、成績証明書と修了(見込)証明書の提出を不要とし、合否判定にも用いません。</p> <p>ただし、修了(見込)証明書については入学手続き時(2021/7/21～7/29)に必要となりますので、それまでに用意してください。</p>
エ 成績証明書 (原本又は原本証明)	
オ 推薦書(様式任意)	出身大学等の学長、研究科長、勤務先上司等のいずれかが作成したもの及び本学での受入れ指導教員が作成したものを各1部提出してください。
カ 志望理由書	本学を志望した動機、理由等を日本語(400字程度)又は英語(100語程度)により記入してください。
キ 研究(希望)計画書	博士後期課程における研究(希望)計画を日本語又は英語により記入してください。
ク 修士論文のコピー 及びその概要	<p><u>修士論文のコピー及びその概要(日本語2,000字又は英語500語程度に要約したもの)を各1部提出してください。</u></p> <p>【博士前期課程(又は修士課程)修了見込みの者】 修士論文課題と研究の進行状況を要約したもの(日本語2,000字又は英語500語程度)を提出してください。</p>
ケ 住民票又はパスポート のコピー	住民票又はパスポートのコピーを提出してください。
※ 検 定 料	不要

注① 上記ア、カ及びキの書類は、本学所定の用紙を用いてください。
なお、用紙は以下のウェブサイトからダウンロードできます。

https://www.muroran-it.ac.jp/entrance/isee/guidelines_is.html

② すべての書類は、日本語又は英語で書かれていなければなりません。証明書等の原本が日本語又は英語以外の言語で書かれている場合は、和訳又は英訳を添付してください。

③ 出願書類に不備があるものは、受理しません。

④ 希望指導教員は、定年退職等により受け入れができないことがありますので、本学公式ウェブサイトですべて確認してください。

https://www.muroran-it.ac.jp/entrance/gsee/guidelines_gs.html

⑤ 出願にあたっては、事前に希望指導教員に教育研究内容等について相談してください。

(3) 出願書類提出先

ア 出願書類原本を国際スピード郵便又は書留郵便で郵送してください。

※ 国際スピード郵便で郵送する場合は、郵送前に出願書類のデータを E メールで入試戦略課入学試験係に送信してください。

イ 出願書類を本学へ送付したことを E メールで連絡してください。

〒050-8585

北海道室蘭市水元町 27 番 1 号

室蘭工業大学 入試戦略課入学試験係

E-mail nyushi@mmm.muroran-it.ac.jp

(4) 検定料について

検定料は不要です。

7 選 抜 方 法

(1) 入学者の選抜

国外出願：書類審査の結果で判定します。

国内出願：口述試験及び書類審査の結果を総合して判定します。

(2) 口述試験日時

2021 年 1 月 23 日（土）午後 1 時 30 分から行います。

8 試 験 場

室蘭工業大学：北海道室蘭市水元町 27 番 1 号

注 試験室については、試験日の前日に本学の教育・研究 3 号館 N 棟掲示板及び各学科掲示板に掲示するとともに、本学公式ウェブサイトに掲載します。

9 合 格 発 表

2021 年 2 月 19 日（金）午前 10 時

合格者受験番号を、本学の教育・研究 3 号館 N 棟 1 階掲示板に掲示するとともに本学公式ウェブサイトに掲載し、合格者には合格通知書を送付します。なお、不合格者には送付物はありません。

また、合格者の中から別途選考によって選ばれた者は、本学が CSC に奨学金受給候補者として推薦します。

10 入学手続

入学手続期間：

2021年7月21日（水）～2021年7月29日（木）※平日のみ

入学試験に合格した者は、入学手続期間内に必要な書類を用意し、入学手続を行ってください。

入学手続に必要な書類及び入学料、授業料納入方法詳細については、合格発表後に送付する入学案内で別途指示します。

入学料 282,000円【予定額】

授業料（参考） 267,900円【予定額】

（年額 535,800円【予定額】を5月と11月の2期に分けて納入）

なお、CSC-MURORANIT 奨学金の受給者に決定した者は、入学料及び授業料が免除されます。
また、CSC-MURORANIT 奨学金受給者には、本学から月額3万円の奨学金が別途支給されます。

11 出願のための参考事項

- (1) 室蘭工業大学は、国立の単科、工科系大学です。
- (2) 博士後期課程は、博士前期課程修了後3か年の課程です。この課程に入学し、所定の単位を修得して研究論文を提出し、最終試験に合格した者に博士(工学)の学位が与えられます。
- (3) 外国人留学生の居住施設として「学生寮」及び「留学生宿舎」があり、空室がある場合は選考のうえ、入居することができます。なお、留学生宿舎については、原則として1年以内の入居に限ります。

12 入学料免除・徴収猶予及び授業料免除・徴収猶予について

CSC-MURORANIT 奨学金受給者とならなかった者については、入学料免除・徴収猶予及び授業料免除・徴収猶予の制度があり、以下の対象者に該当する者は申請することができます。

(1) 入学料免除の対象者

経済的な理由によって入学料の納入が困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる者。

(2) 入学料徴収猶予の対象者

経済的な理由によって納入期限までに入学料の納入が困難であり、かつ、学業成績が優秀と認められる者。

(3) 免除申請書または徴収猶予申請書を提出して受理された者は、免除または猶予の許可、不許可の決定があるまでは入学料を納入しないでください。納入した場合は申請が無効になります。

(4) 授業料免除・徴収猶予については、合格発表後に送付する入学手続に関する書類で別途指示します。

(5) 入学料免除または入学料徴収猶予制度を申請し、入学手続を完了させた後に入学を辞退した場合、申請は不許可となり、入学料を納入する必要があります。

入学料免除・徴収猶予及び授業料免除・徴収猶予に関する問合せ先

〒050-8585

北海道室蘭市水元町27番1号

室蘭工業大学 学務課学生支援係

E-mail kousei@mmm.muroran-it.ac.jp

受付時間 午前8時30分～午後5時15分（正午～午後1時を除く）※平日のみ

11. 職歴 Employment Record

職 場 名 Name of Company or Employer	所 在 地 Location	職名 Job Title	勤 続 期 間 Period of Employment
			From to
			From to
			From to

12. 日本語の知識 Proficiency in Japanese Language

読解力 Reading	優 <input type="checkbox"/> Excellent	良 <input type="checkbox"/> Good	可 <input type="checkbox"/> Fair	不可 <input type="checkbox"/> Poor
会話力 Speaking	優 <input type="checkbox"/> Excellent	良 <input type="checkbox"/> Good	可 <input type="checkbox"/> Fair	不可 <input type="checkbox"/> Poor
筆記力 Writing	優 <input type="checkbox"/> Excellent	良 <input type="checkbox"/> Good	可 <input type="checkbox"/> Fair	不可 <input type="checkbox"/> Poor
聴取力 Listening	優 <input type="checkbox"/> Excellent	良 <input type="checkbox"/> Good	可 <input type="checkbox"/> Fair	不可 <input type="checkbox"/> Poor

日本語の学習歴 Japanese Language Background, if any

学 習 機 関 名 Name of Institution	所 在 地 Location	学 習 期 間 Period of Study
		From To
		From To
		From To

13. 外国語の知識 Proficiency in Foreign Language

English	優 <input type="checkbox"/> Excellent	良 <input type="checkbox"/> Good	可 <input type="checkbox"/> Fair	不可 <input type="checkbox"/> Poor
French	<input type="checkbox"/> Excellent	<input type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Fair	<input type="checkbox"/> Poor
German	<input type="checkbox"/> Excellent	<input type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Fair	<input type="checkbox"/> Poor
Spanish	<input type="checkbox"/> Excellent	<input type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Fair	<input type="checkbox"/> Poor
Other ()	<input type="checkbox"/> Excellent	<input type="checkbox"/> Good	<input type="checkbox"/> Fair	<input type="checkbox"/> Poor

志望理由書

STATEMENT OF REASON FOR APPLICATION

受験
番号

この欄は必ずしも記入しないこと

Fill boxes with ✓

- CSC-MuroranIT 奨学金入試国内出願
(CSC-MuroranIT Scholarship Entrance Examination (Domestic Application))
- CSC-MuroranIT 奨学金入試国外出願
(CSC-MuroranIT Scholarship Entrance Examination (Overseas Application))

氏名 (Name in Full)	
志望コース (Course you apply for)	

研究（希望）計画書

RESEARCH PLAN

受験番号	この欄には何も記入しないこと
------	----------------

* いずれかの項目に✓を記入すること。（* Put ✓ in box below）

入学区分	2021 年度 10 月入学（ DATE OF ENTRANCE: OCTOBER, 2021）
選抜区分	<input type="checkbox"/> CSC-MuroranIT 奨学金入試国内出願 （CSC-MuroranIT Scholarship Entrance Examination (Domestic Application)） <input type="checkbox"/> CSC-MuroranIT 奨学金入試国外出願 （CSC-MuroranIT Scholarship Entrance Examination (Overseas Application)）

以下の a～g について順を追って記述すること。（Prepare a document in order of a to g）

- 研究のタイトル（Research subject）
- これまでの研究の背景と解決すべき課題（Research background and issue to be dissolved）
- 課題解決の方法と特色，独創性（Originality of research）
- この研究の波及効果（Expected results and impacts）
- DC コースでの研究目的及び研究計画（Objectives and research outline）
- 年次計画内容の詳細（Details of your research plan for each academic year）
- 投稿を目指す論文雑誌名（The journal you intend to submit）

氏名（Name in Full）	
志望コース（Course you apply for）	

最大4ページまで
(Up to 4 pages of document)